# İÇİNDEKİLER

ŞEKILLER	2
TABLOLAR	2
KISALTMALAR	3
1. CMOS Akım Taşıyıcılar	4
1.1 CMOS Akım Taşıyıcılarının Benzetimi	4
1.1.1 Bir Numaralı CCII+ Devre Yapısı	5
1.1.2 İki umaralı CCII+ Devre Yapısı	8
1.1.3 Üç Numaralı CCII+ Devre Yapısı	10
2. CCII+ ile Çoklu Girişli Tek Çıkışlı Filtre Tasarımı	13
2.1 Alçak Geçiren Filtre Devresi	14
2.2 Bant Geçiren Filtre Devresi	17
2.3 Yüksek Geçiren Filtre Devresi	19
REFERANSLAR	21

# ŞEKİLLER

Şekil 1 : (a) Pozitif Akım Yaşıyıcı, (b) Negatif Akım Taşıyıcıları	4
Şekil 2 : CCII+ için oluşturulmuş LTSpice Sembolu	5
Şekil 3 : Bir numaralı devre yapısının LTSpice şeması	6
Şekil 4 : Bir numaralı devre Giriş / Çıkış Gerilim Grafiği	7
Şekil 5 : Bir Numaralı Devreli Gerilim Kazanç Grafiği	7
Şekil 6 : İki numaralı devre yapısının LTSpice şeması	8
Şekil 7 : İki numaralı devre Giriş / Çıkış Gerilim Grafiği	9
Şekil 8 : İki Numaralı Devreli Gerilim Kazanç Grafiği	10
Şekil 9 : Üç numaralı devre yapısının LTSpice şeması	11
Şekil 10 : Üç numaralı devre Giriş / Çıkış Gerilim Grafiği	12
Şekil 11 : İki Numaralı Devreli Gerilim Kazanç Grafiği	12
Şekil 12 : Çoklu Girişli Tek Çıkışlı Filtre Yapısı	13
Şekil 13 : LTSpice Üzerinde Kurunlan Alçak Geçiren Filtre Devresi	14
Şekil 14 : Alçak Geçiren Filtre Frekans Cevabı	15
Şekil 15 : 10kHz Giriş/Çıkış Grafiği	15
Şekil 16 : 30kHz Giriş/Çıkış Grafiği	16
Şekil 17 : 500kHz Giriş/Çıkış Grafiği	17
Şekil 18 : LTSpice Üzerinde Kurunlan Alçak Geçiren Filtre Devresi	18
Şekil 19 : Bant Geçiren Filtre Frekans Cevabı	18
Şekil 20 : LTSpice Üzerinde Kurunlan Yüksek Geçiren Filtre Devresi	19
Şekil 21 : Yüksek Geçiren Filtre Frekans Cevabu	20
MADY OV AD	
TABLOLAR	
Tablo 1 : Bir numaralı devre yapısı CMOS boyutları	
Tablo 2 : İki numaralı devre yapısı CMOS boyutları	
Tablo 3 : Üç numaralı devre yapısı CMOS boyutları	11

## KISALTMALAR

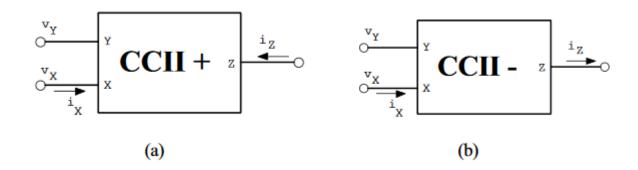
CCII +: 2. Generation Positive Current Conveyor (İkinci Nesi Pozitif Akım Taşıyıcı)

CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor (Bütünleyici Metal Oksit Yarı İletken)

## 1. CMOS Akım Taşıyıcılar

Birinci kuşak akım taşıyıcıları, 1968 Sedra ve Smith tarafından ortaya atışmıştır. Günümüzde kullanılan ikinci kuşak akım taşıyıcıları 1970 yılında aynı kişiler tarafından geliştirilmiştir.Aktif eleman olarak kullanılan akım taşıyıcıları aktif süzgeç(filtre), osilatör gibi devrelerin gerçeklenmesinde kullanılmaktadır[1].

Pozitif akım taşıyıcıları ve negatif akım taşıyıcıları olmak üzere iki çeşit akım taşıyıcısı bulunmaktadır. Akım taşıyıcıların devre sembolleri **Sekil 1**'de görülmektedir.



Şekil 1 : (a) Pozitif Akım Yaşıyıcı, (b) Negatif Akım Taşıyıcıları

Akım taşıyıcılar aşağıdaki eşitlikleri sağlayan devre yapılarıdır.  $I_z = I_x$  olması durumunda pozitif akım taşıyıcısı olarak adlandırılken,  $I_z = -I_x$  olması durumunda ise negatif akım taşıcıları olarak adlandırılmaktadır.

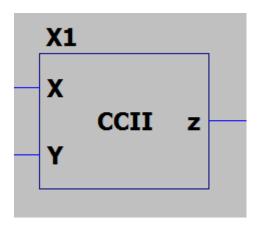
$$V_x = V_y$$

$$I_z = 0$$

$$I_z = \pm I_x$$

#### 1.1 CMOS Akım Taşıyıcılarının Benzetimi

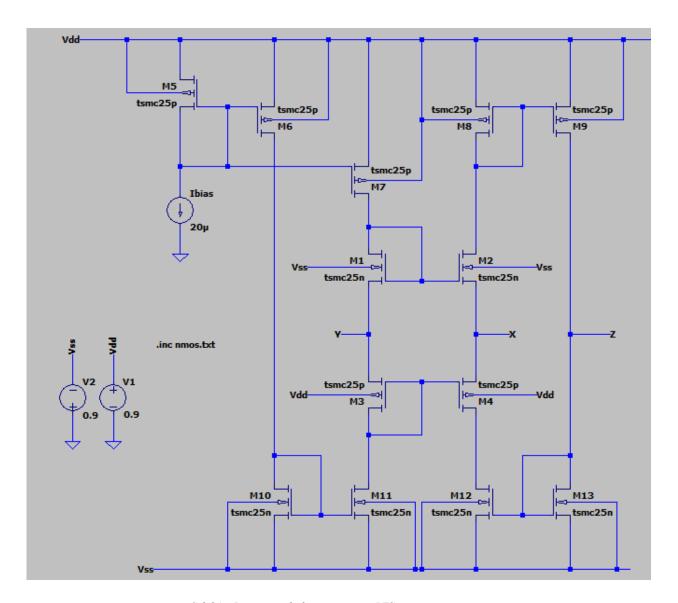
CMOS akım taşıyıcıların benzetimi için üniversite hocaları tarafından geliştirilmiş üç farklı [2][3][4] CMOS akım taşıyıcısı yapıları kullanılmıştır. Devre yapıları LTSpice yazılımında oluşuturulduktan sonra **Şekil 2**'deki gibi temsil edilmiştir.



Şekil 2 : CCII+ için oluşturulmuş LTSpice Sembolu

## 1.1.1 Bir Numaralı CCII+ Devre Yapısı

Bir numaralı devrenin, LTSpice yazılımında oluşturulmuş devre yapısı Şekil 3'te görülmektedir. Devre içerisinde kullanılan CMOS'ların W ve L oranları ile ise Tablo 1'de görülmektedir.

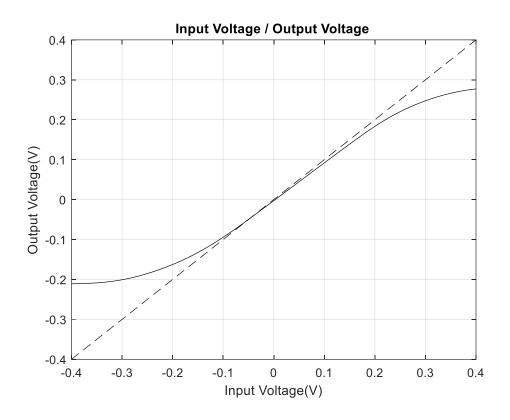


Şekil 3 : Bir numaralı devre yapısının LTSpice şeması

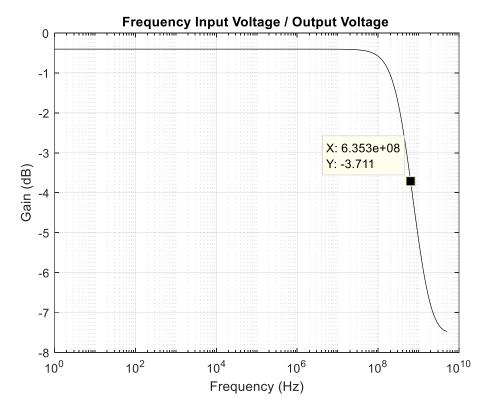
CMOS	W(um) / L(um)
M1, M2	60 / 0.18
M3, M4	90 / 0.18
M5, M6	20 / 0.18
<b>M</b> 7	22 / 0.18
M8, M9	28 / 0.18
M10, M11	02 / 0.18
M12, M13	17 / 0.18

Tablo 1 : Bir numaralı devre yapısı CMOS boyutları

Bu devre yapısı için Giriş Gerilimi $(V_y)$  / Çıkış Gerilimi $(V_x)$ , Gerilim Kazanç grafikleri elde edilmiştir. Elde edilen grafikler **Şekil 4** ve **Şekil 5**'de görülmektedir.



Şekil 4 : Bir numaralı devre Giriş / Çıkış Gerilim Grafiği

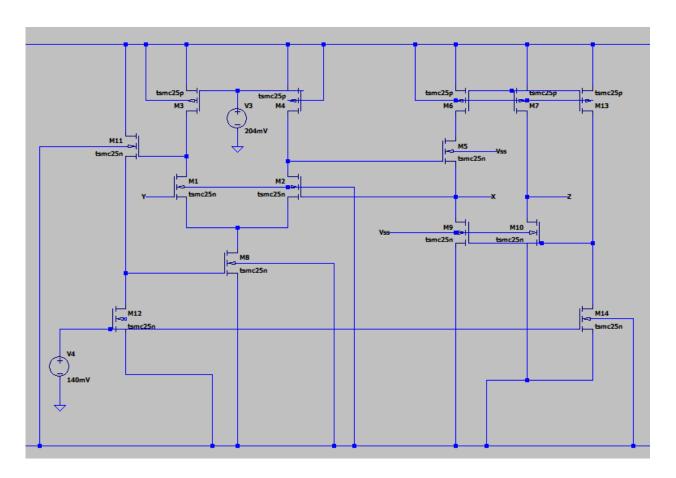


Şekil 5 : Bir Numaralı Devreli Gerilim Kazanç Grafiği

Şekil 4'te grafik incelendiğinde devre yapısının yaklaşık olarak -100mV ile 200mV arasında doğrusal olarak çalıştığı göstermektedir.. Şekil 5'teki grafik ise CCII+ yapısında çalıştığını doğrulamaktadır. Ancak kazanç ekseni incelendiğinde gerilim kayması kolaylıkla görülmektedir.

### 1.1.2 İki umaralı CCII+ Devre Yapısı

İki numaralı devrenin, LTSpice yazılımında oluşturulmuş devre yapısı Şekil 6'da görülmektedir. Devre içerisinde kullanılan CMOS'ların W ve L oranları ile ise Tablo 2'de görülmektedir.

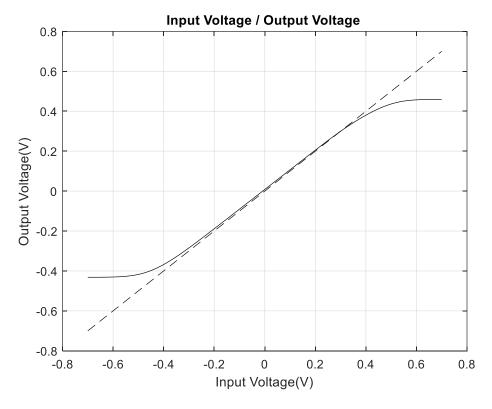


Şekil 6 : İki numaralı devre yapısının LTSpice şeması

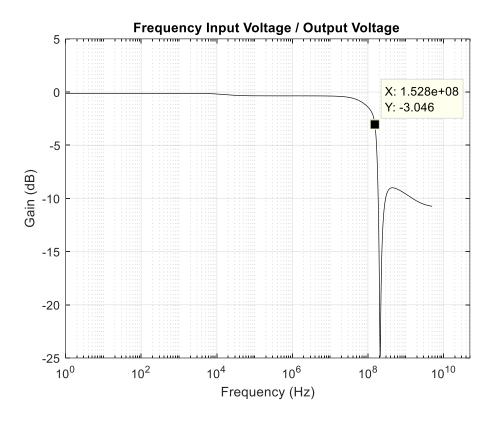
CMOS	W(um) / L(um)
M1, M2	60 / 1
M3, M4	10 / 2.5
M5, M11	4 / 0.5
M6, M7	100 / 2.5
<b>M</b> 8	5 / 2.5
M9, M10	50 / 2.5
M12	5 / 2.5
M13	2.5/2.5
M14	10/2.5

Tablo 2 : İki numaralı devre yapısı CMOS boyutları

Bu devre yapısı için Giriş Gerilimi $(V_y)$  / Çıkış Gerilimi $(V_x)$ , Gerilim Kazanç grafikleri elde edilmiştir. Elde edilen grafikler **Şekil 7** ve **Şekil 8**'de görülmektedir.



Şekil 7 : İki numaralı devre Giriş / Çıkış Gerilim Grafiği

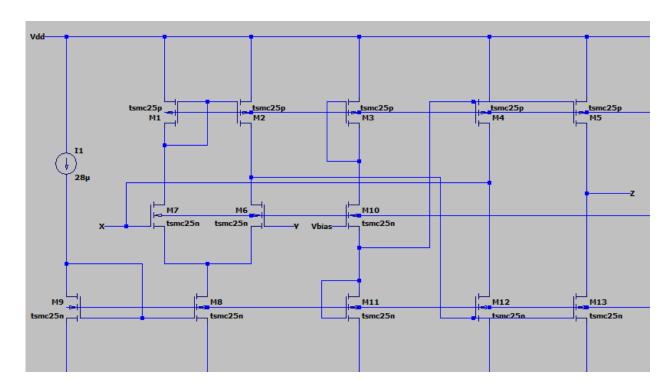


Şekil 8 : İki Numaralı Devreli Gerilim Kazanç Grafiği

Şekil 7'te grafik incelendiğinde devre yapısının yaklaşık olarak -400mV ile 400mV arasında doğrusal olarak çalıştığı göstermektedir. Bir önceki devre yapısına göre bakıldığında bu devreni yapısı hem simetrik hem de daha geniş bir giriş voltajı aralığından çalıştığı gözlenmiştir. Şekil 8'teki grafik ise CCII+ yapısında çalıştığını doğrulamaktadır. Bu devre yapısının tasarlandığı makalede[3], devre yapısının amacının düşük güçlerde çalışmadığı olduğu görülmüştür. Devre yapısı bu özelliği kazandırılmasına yüksek frekanslarda gerilim kazancının artımasına neden olmuştur.

### 1.1.3 Üç Numaralı CCII+ Devre Yapısı

İki numaralı devrenin, LTSpice yazılımında oluşturulmuş devre yapısı **Şekil 9**'da görülmektedir. Devre içerisinde kullanılan CMOS'ların W ve L oranları ile ise **Tablo 3**'de görülmektedir.

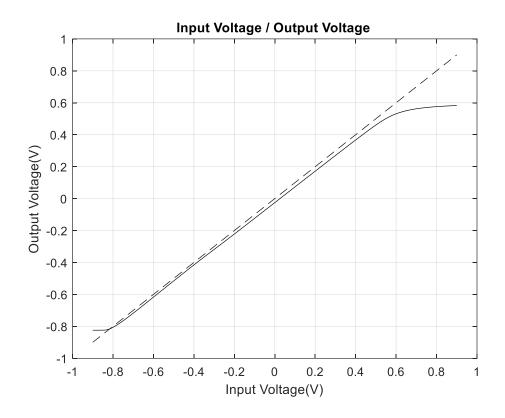


Şekil 9 : Üç numaralı devre yapısının LTSpice şeması

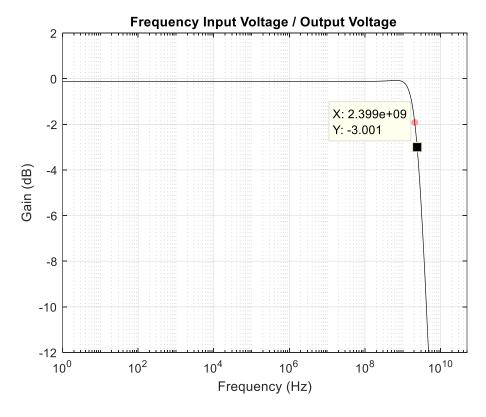
CMOS	W(um) / L(um)
M1	5.52u / 0.18u
M2	2u / 0.18u
M3, M4, M5,M10	8u / 0.18u
M6	0.5u / 0.18u
M7,M9	2.5u / 0.18u
<b>M</b> 8	4u / 0.18u
M11, M12, M13	10u / 0.18u

Tablo 3 : Üç numaralı devre yapısı CMOS boyutları

Bu devre yapısı için Giriş Gerilimi $(V_y)$  / Çıkış Gerilimi $(V_x)$ , Gerilim Kazanç grafikleri elde edilmiştir. Elde edilen grafikler **Şekil 10** ve **Şekil 11**'de görülmektedir.



Şekil 10 : Üç numaralı devre Giriş / Çıkış Gerilim Grafiği

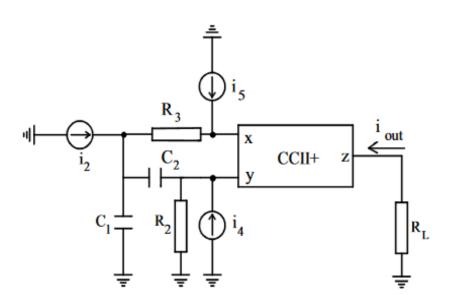


Şekil 11 : İki Numaralı Devreli Gerilim Kazanç Grafiği

**Şekil 10**'daki grafik incelendiğinde devre yapısının yaklaşık olarak -800mV ile 500mV arasında doğrusal olarak çalıştığı göstermektedir. **Şekil 11**'deki grafik ise CCII+ yapısında çalıştığını doğrulamaktadır. Diğer iki devre yapısının kesme frekansları incelendiği zaman en yüksek kesme frekansına sahip devre yapısı olduğu görülmektedir.

### 2. CCII+ ile Çoklu Girişli Tek Çıkışlı Filtre Tasarımı

Bu filtre yapıları tasarlanırken [5] numaralı makaleden yararlanışmıştır. Devre yapısı Şekil 12'de görülmektedir.



Şekil 12 : Çoklu Girişli Tek Çıkışlı Filtre Yapısı

Alçak geçiren filtre şartı  $i_4 = i_5 = 0$ .

(1) 
$$\frac{Iout}{i_2} = \frac{G_2G_3}{s^2C_1C_2 + s(C_1 + C_2)G_2 + G_2G_3}$$

Bant geçiren filtre şartı  $i_2 = i_5 = 0$ 

(2) 
$$\frac{lout}{i_4} = \frac{C_1 G_3}{s^2 C_1 C_2 + s(C_1 + C_2) G_2 + G_2 G_3}$$

Yüksek geçiren filtre şartı 
$$i_2=-i_5$$
 ,  $i_4=i_5\frac{G_2(C_1+C_2)}{G_1G_3}$ 

(3) 
$$\frac{Iout}{i_5} = \frac{s^2 C_1 C_2}{s^2 C_1 C_2 + s(C_1 + C_2)G_2 + G_2 G_3}$$

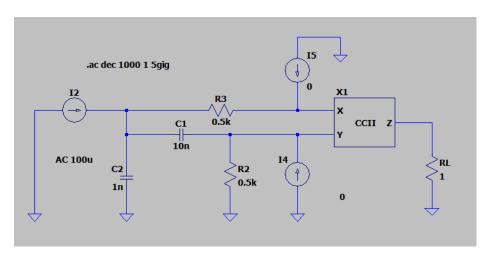
Direnç ve kapasitör elemanlarının hesaplamaları aşağıda görülmektedir.

(1) 
$$R3, R2 = 10k\Omega, C1 = 10nF, C2 = 1nF$$

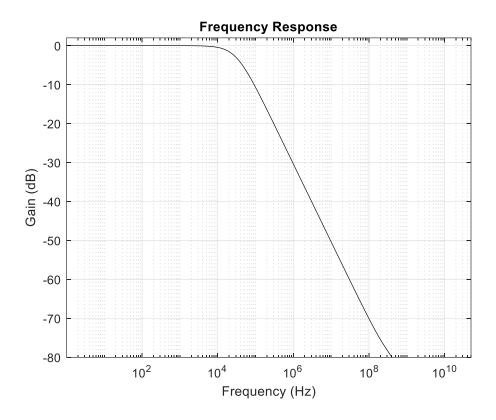
(2) 
$$f = 100660 \, Hz$$

#### 2.1 Alçak Geçiren Filtre Devresi

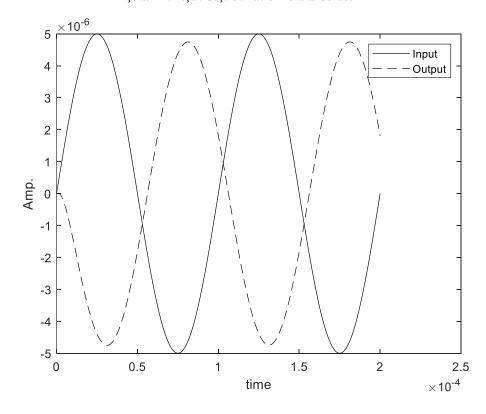
Kurulan devre şeması **Şekil 13**'te görülmektedir. Devre'nin kazanç grafiği **Şekil 14**'te görülmektedir. Beklenen alçak geçiren filtre grafiğine en iyi veren üç numaralı CCII+ yapısı seçilmiştir. Kazanç grafiği incelendiğinde kesme frekansı 30kHz olarak gözlenmiştir. Devreye 10kHz, 30kHz ve 500kHz'lik akım işaret uygulanmıştır. Sonuç grafikleri sırasıyla **Şekil 15**, **Şekil 16** ve **Şekil 17**'de görülmektedir.



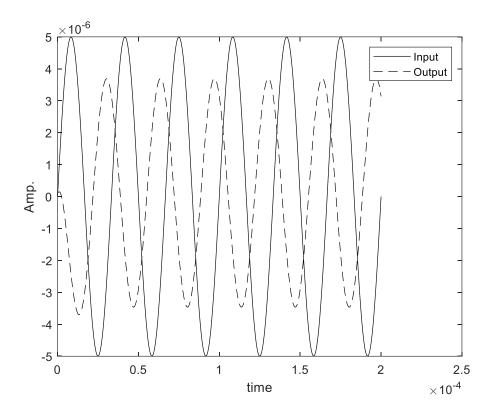
Şekil 13 : LTSpice Üzerinde Kurunlan Alçak Geçiren Filtre Devresi



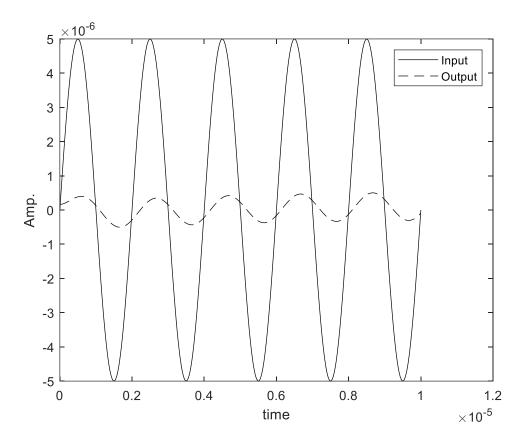
Şekil 14 : Alçak Geçiren Filtre Frekans Cevabı



Şekil 15 : 10kHz Giriş/Çıkış Grafiği



Şekil 16 : 30kHz Giriş/Çıkış Grafiği

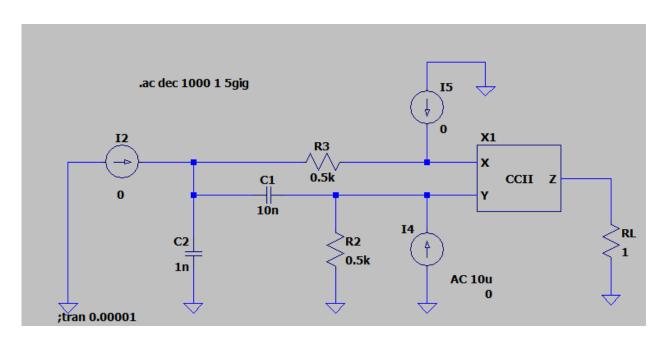


Şekil 17 : 500kHz Giriş/Çıkış Grafiği

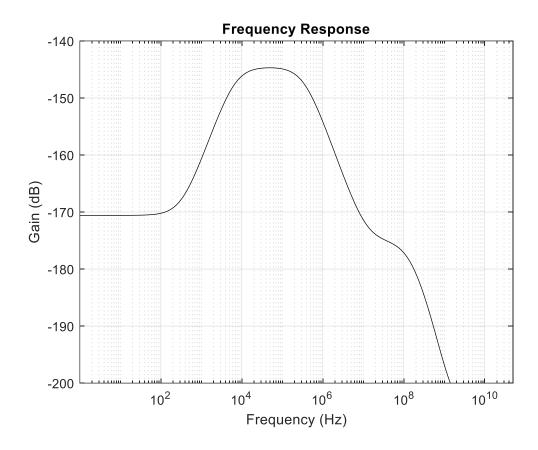
Hesaplanan kesme frekansı ile kurulan devredenin kesme frekansının farklı olmasının sebebi, CMOS'ların çalışmalarından dolayı iç yapılarında oluşan kapasite etkisinden kaynaklanmaktadır.

#### 2.2 Bant Geçiren Filtre Devresi

Kurulan devre şeması **Şekil 18**'te görülmektedir. Devre'nin kazanç grafiği **Şekil 18**'te görülmektedir. Beklenen band geçiren filtre grafiğine en iyi veren iki numaralı CCII+ yapısı seçilmiştir. Kazanç grafiği incelendiğinde kesme frekansı yaklaşık olarak 100kHz civarında gözlenmiştir.



Şekil 18 : LTSpice Üzerinde Kurunlan Alçak Geçiren Filtre Devresi

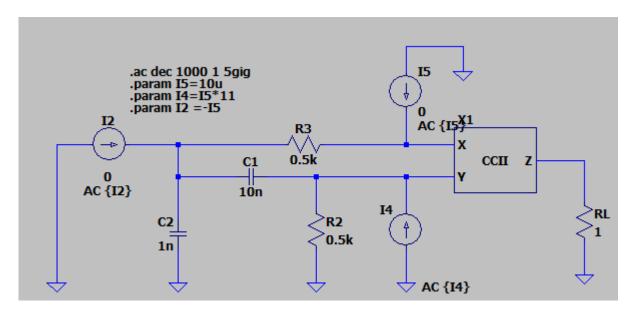


Şekil 19 : Bant Geçiren Filtre Frekans Cevabı

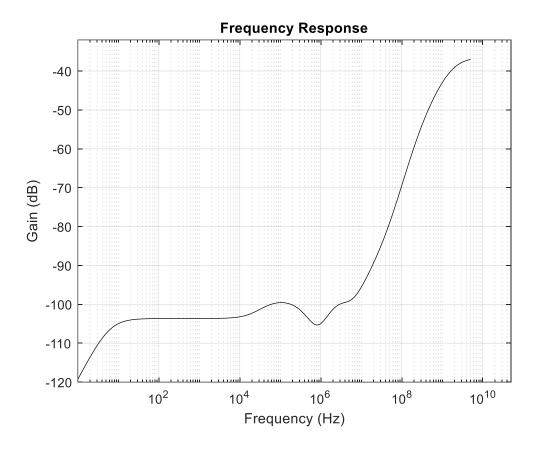
Frekans cevabı, band geçiren filtre yapısına ve tasarımın yapıldığı makale uyuşmasına rağmen kazanç değer oldukça küçük kalmaktadır. Bundan dolayı devreye uygulanan akım işaretleri alınamamıştır.

#### 2.3 Yüksek Geçiren Filtre Devresi

Kurulan devre şeması **Şekil 20**'te görülmektedir. Devre'nin kazanç grafiği **Şekil 21**'te görülmektedir. Beklenen yüksek geçiren filtre grafiğine en iyi veren iki numaralı CCII+ yapısı seçilmiştir. Kazanç grafiği incelendiğinde kesme frekansı yaklaşık olarak 100kHz civarında gözlenmiştir. Ancak 100kHz'den sonra kısımlarda frekans cevabında dalgalamalar gözlemlenmiştir.



Şekil 20 : LTSpice Üzerinde Kurunlan Yüksek Geçiren Filtre Devresi



Şekil 21 : Yüksek Geçiren Filtre Frekans Cevabu

Frekans cevabı, yüksek geçiren filtre yapısına ve tasarımın yapıldığı makale uyuşmasına rağmen kazanç değer oldukça küçük kalmaktadır. Bundan dolayı devreye uygulanan akım işaretleri alınamamıştır.Buna ek olarak filtre belirlenen frekansta geçirmeye başlarken CMOS 110kHz ve 6 MHz aralığında kutuplamadan kaynakları bozunmalar olmuştur.

#### **REFERANSLAR**

- [1] H. H. Kuntman: Analog MOS Tümdevre Tekniği, İTÜ Kütüphanesi, Sayı: 1587, 1997, Bölüm 5
- [2] Hassen, Néjib & Ettaghzouti, Thouraya & Besbes, Kamel. (2011). High-performance Second-Generation Controlled Current Conveyor CCCII and High Frequency Applications. World Academy of Science, Engineering and Technology. vol. 5.. pp. 851-860.
- [3] S. Hassanein, Wessam & A. Awad, Inas & Soliman, A.M.. (2004). New wide band low power CMOS current conveyors. Analog Integrated Circuits and Signal Processing. 40. 91-97. 10.1023 / B:ALOG.0000031439.62496.f9.
- [4] Singh, Shobhit & Jain, Jitendra & Goswami, Manish & Srivastava, Harsh. (2013). Design of Wideband Current Conveyor (CC-II) based Oscillator for Low-Voltage Application using 180nm CMOS Technology.. CARE 2013 2013 IEEE International Conference on Control, Automation, Robotics and Embedded Systems, Proceedings. 10.1109 / CARE.2013.6733722.
- [5] Özcan, Sadri, Oğuzhan Çiçekoğlu, and Hakan Kuntman. "Multi-Input Single-Output Filter with Reduced Number of Passive Elements Employing Single Current Conveyor." Computers & Electrical Engineering 29 (2003): 45–53. Web.